

2011年4月15日

<ご参考資料>

* 2011年4月14日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳です。

インテルとマイクロン

業界最小、最先端の20nmプロセス技術 NAND型フラッシュメモリーを発表
～ タブレット端末、スマートフォン、SSD、デジタル家電機器などに適した
小型かつ大容量の8Gバイトの新しいNANDフラッシュメモリー ～

ニュース・ハイライト

- インテルとマイクロンが、業界最小の20nm (ナノメートル) プロセス技術を開発
- IM フラッシュ・テクノロジーズは、ファブ・ネットワーク全体の20nmプロセス技術への迅速な移行で先行
- ダイサイズ 118mm² (平方ミリ) の8Gバイト多値セル NAND型フラッシュメモリーで、スマートフォン、タブレット端末、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) などに適した大容量を実現

インテル コーポレーション (本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ) とマイクロン テクノロジー社 (本社 : アイダホ州ボイジー) は本日、NAND 型フラッシュメモリーの製造に利用される業界最先端の 20nm (ナノメートル) プロセス技術を発表しました。この新しい 20nmプロセス技術は 8Gバイト (GB) の多値セル (MLC) NAND 型フラッシュメモリーを実現し、スマートフォン、タブレット端末、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) などのコンピューティング機器での音楽、ビデオ、電子書籍などのデータ保存に適した、小型で大容量のストレージを追加できます。

データ処理量の増加とタブレットやスマートフォンの機能の充実により、新しい NAND 型フラッシュ技術は、特に小型で大容量を実現する設計が求められています。20nmプロセス技術による8GBの新しいNANDフラッシュメモリーの面積は約 118mm² (平方ミリ) です。これは、インテルとマイクロン両社の従来の 25nm プロセス技術に基づく8GB NAND 型フラッシュメモリーと比較して、ボード面積で 30~40% (パッケージの種類によって異なる) の削減になります。フラッシュ・ストレージの占有面積の縮小により、システム・レベルの設計自由度が向上するため、タブレット端末やスマートフォンのメーカーは、空いた部分をバッテリーの大型化や画面の拡大、新機能のためのチップの搭載など、最終製品の改善に利用できます。

インテルとマイクロンの合併会社である IM フラッシュ・テクノロジーズ (IMFT) によって製造される新しい 20nm プロセス技術に基づく 8GBのNANDフラッシュメモリーは、プロセス技術と技術設計の面で大きな進歩しており、半導体リソグラフィ技術における両社のリーダ

ーシップをさらに強固なものにするものです。NANDの半導体リソグラフィー技術を20nmにまで微細化することで、工場の生産性を最もコスト効率良く高め、従来の技術と比較してGB換算で約50%高い工場の生産性を達成しています。新しい 20nmプロセス技術は、前世代の 25nm プロセス技術に基づくNAND 型フラッシュメモリーと同様の性能と耐久性を維持しています。

マイクロン テクノロジー社 NAND ソリューション事業担当副社長のグレン・ホークは「お客様と緊密に協力することはマイクロンのコアバリューの1つであり、当社ではお客様との関係構築を通じて NAND 型フラッシュ・ストレージを最終製品に組み込む機会を得ました。当社のイノベーションと成長は継続しています。当社は、20nmプロセス 技術によって、コスト効率と付加価値の高いSSDソリューションをお客様にお届けします」と述べています。

インテル コーポレーション 副社長 兼 NANDソリューション事業部長のトム・ランポーンは「当社の目標は、手ごろな価格かつ簡単に、世界の情報へのアクセスを可能にすることです。当社は、業界をリードする NAND 型フラッシュ技術により、最高の品質で最高のコスト効率のソリューションを何世代にもわたりお客様に提供しています。インテルとマイクロンによる合弁会社は、プロセス技術で業界をリードし、ファブ・ネットワーク全体を、より小さな半導体リソグラフィー技術への迅速な移行において、業界のモデルとなっています」と述べています。

20nmプロセス技術を採用した8GB製品は本日よりサンプル出荷を開始し、2011年後半期に量産出荷を予定しています。同時に、インテルとマイクロンは、米国の郵便切手より小さい、最大128GBの容量のSSDを設計できる16GB製品のサンプル出荷も予定しています。

マイクロン テクノロジー社について

マイクロン テクノロジー社は、先進的な半導体ソリューションを提供する世界的大手企業です。マイクロンは、世界全域での事業活動を通じ、最先端のコンピューター、家電製品、ネットワーク、組み込み製品、モバイル機器などに使用される、DRAM、NANDおよびNORフラッシュメモリー全般、およびその他の革新的メモリ技術、パッケージングソリューション、半導体システムなどを製造・販売しています。マイクロン テクノロジー社の普通株式はNASDAQにMUのコード名で上場取引されています。マイクロン テクノロジー社に関する情報は、www.micron.comをご覧ください。

インテルについて

シリコンの技術革新で世界をリードするインテルは、人々の仕事と生活をさらに豊かにする先進的な技術と製品を開発、イニシアチブを推進していきます。インテルに関する情報は、www.intel.co.jpで入手できます。

- * Intel、インテル、Intelロゴは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- * マイクロンおよびマイクロンのロゴは、マイクロン テクノロジー社の商標です。
- * その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

このプレスリリースは、20nm 8GB, 16GB NAND デバイスの生産に関する将来予測を含んでいます。実際の事象や結果は、将来予測に含まれたものとは異なる可能性があります。マイクロン社が、その都度、米証券取引委員会に提出した連結ベースの書類、具体的には、当社直近の「10-K」と「10-Q」を参照ください。これらの書類は、実際の結果が当社にとり連結ベースで当社の、「将来予測」(「一部の要因」参照)に記載されたものと実質的に異なる原因となり得る重要な要因を含むと共に、それらを特定しています。「将来予測」に示された期待は妥当だと考えられますが、当社は将来の結果、活動のレベル、実績、業績などを保証するものではありません。

この件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

インテル株式会社
広報室 荒木

Tel: (03) 5223-9100 (代表)

マイクロン ジャパン株式会社
才宮 章子

Tel: (0795)23-6609

E-mail: saimiya@micron.com